

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 10-154792

(43)Date of publication of application : 09.06.1998

(51)Int.Cl.

H01L 27/04

H01L 21/822

H01L 27/115

H01L 21/8247

H01L 29/788

H01L 29/792

(21)Application number : 08-310935

(71)Applicant : SANYO ELECTRIC CO LTD

(22)Date of filing : 21.11.1996

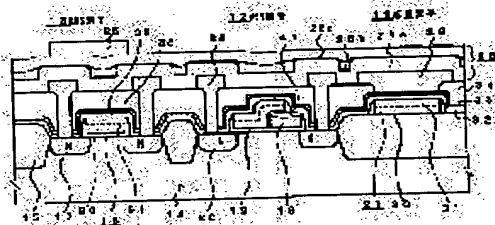
(72)Inventor : AOYAMA MASASHIGE
MORIKAWA NARIHIRO

(54) SEMICONDUCTOR INTEGRATED CIRCUIT AND ITS MANUFACTURING METHOD

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To incorporate a capacitance element having excellent characteristics in a semiconductor integrated circuit through a simple process, by forming the capacitance element of a gate electrode and an aluminum electrode having low specific receptivity.

SOLUTION: A gate electrode 16 composed of a polysilicon layer and a silicide film is simultaneously formed with the lower electrode 21 of a capacitance element 11. The surface of the silicide film is coated with a TEOS film 32 and a silicon nitride film 33, and the films 32 and 33 are used as a dielectric substance. An opening is formed through an insulating film and the upper electrode 22 of the capacitance element 11 is formed of an aluminum electrode material.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the

examiner's decision of rejection or application
converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of
rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's
decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

*** NOTICES ***

Japan Patent Office is not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1.This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.

2.*** shows the word which can not be translated.

3.In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

[Claim(s)]

[Claim 1] A semiconductor integrated circuit characterized by providing the following A floating-gate electrode formed in the surface of an element field surrounded with a LOCOS oxide film A comparatively thick insulator layer formed on said floating-gate electrode A control gate electrode formed so that it might straddle the surface of said element field, and on said comparatively thick insulator layer Said control gate electrode and a lower electrode of a capacitive element formed on said LOCOS oxide film at a coincidence target, A dielectric thin film which covers the 1st insulator layer [which covers said control gate electrode and said lower electrode top], and 1st insulator layer top, An up electrode which counters with said lower electrode by the 2nd insulator layer which covers said dielectric thin film top, opening of said 2nd insulator layer which exposes the surface of said dielectric thin film in the upper part of said lower electrode, and said opening

[Claim 2] A manufacture method of a semiconductor integrated circuit characterized by providing the following A production process which carries out selective oxidation of the surface of a semiconductor layer of one conductivity type, and forms a LOCOS insulator layer A production process which forms a floating-gate electrode in the surface of a semiconductor layer of said one conductivity type surrounded with said LOCOS oxide film A production process which forms a control gate electrode so that said floating-gate electrode top may be straddled said semiconductor layer top, and forms a lower electrode of a capacitive element on said LOCOS oxide film A production process which covers said control gate electrode and said lower electrode top with the 1st insulator layer, and forms a dielectric thin film on said 1st insulator layer further, a production process which forms the 2nd insulator layer on said dielectric thin film, a production process which forms opening in a portion corresponding to said lower electrode of said 2nd insulator layer, and a production process which forms said lower electrode and an up electrode of a capacitive element which counters so that said opening may be covered

[Claim 3] A semiconductor integrated circuit according to claim 1 characterized by for said control gate electrode possessing a laminated structure of polycrystalline silicon and a silicide film, and using a laminated structure of said 1st insulator layer and said dielectric thin film as a dielectric.

[Claim 4] A semiconductor integrated circuit according to claim 1 characterized by having arranged an electrode which is insulated with said control gate electrode and impresses electric field above said control electrode at said floating-gate electrode.

[Translation done.]

*** NOTICES ***

Japan Patent Office is not responsible for any damages caused by the use of this translation.

1.This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.

2.**** shows the word which can not be translated.

3.In the drawings, any words are not translated.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention]

[0001]

[The technical field to which invention belongs] This invention relates to the manufacture method of the semiconductor integrated circuit which can include a comparatively mass capacitive element in an MOS mold integrated circuit at a simple production process.

[0002]

[Description of the Prior Art] Although the simplest structure as a capacitive element included in an integrated circuit is the structure of using a PN junction, the configuration of the MOS mold using an oxide film as a dielectric, the MIS mold using a silicon nitride as a dielectric, and the MIM mold with which both use an electrode wiring material as a counterelectrode is considered since the capacity value acquired is small, for example, as indicated by JP,03-69152,A.

[0003] The configuration of an MIS mold is a configuration which formed the silicon nitride 2 on it by having used the N⁺ diffusion layer 1 as the lower electrode, and formed the up electrode 3 on it, as shown in drawing 7 (A). As shown in drawing 7 (B), the configuration of an MIM mold forms the silicon nitride 5 on Perilla frutescens (L.) Britton var. crispa (Thunb.) Decne. as the lower electrode 4 for a part of electrode wiring layer, and forms the up electrode 6 in an electrode wiring layer on it further.

[0004] These capacitive elements have a strong demand to include in digital one LSI, such as a microcomputer and logic, as for example, an object for switched capacitor filter circuits.

[0005]

[Problem(s) to be Solved by the Invention] However, incorporating such a capacitive element in the LSI process complicated and integrated highly increasingly has the defect of complicating a process further.

[0006]

[Means for Solving the Problem] In view of the conventional technical problem mentioned above, accomplished this invention, and it forms a gate electrode and a lower electrode of a capacitive element in coincidence. Deposit on the whole the 1st insulator layer and dielectric thin film which cover a gate electrode, and by preparing an up electrode so that the 1st insulator layer and dielectric thin film may be used as a dielectric of a capacitive element An integrated circuit which also covers elements other than a capacitive element with a dielectric thin film, and can improve the reliability of an element is offered simplifying a production process.

[0007]

[Embodiment of the Invention] The gestalt of the 1 operation of this invention to the following is explained to details, referring to a drawing. Drawing 1 is the cross section showing an example of the integrated circuit of this invention, and is the example which integrated the capacitive element 11, the memory device 12 of a flash plate mold, and the N-channel MOS element 13. The LOCOS oxide film for isolation formed when 14 showed the semiconductor layer of P type and 15 carried out selective oxidation of the surface of the semiconductor layer 14 in this drawing, The gate electrode of MOS device 13 and 17 16 The N type source drain field of MOS device 13, The control gate where 18 is located in the floating-gate electrode of the flash plate mold memory device 12, and 19 is located on the floating-gate electrode 18, For the lower electrode of a capacitive element 11, and 22, as for an interlayer insulation film and 24, the up electrode of a capacitive element 12 and 23 are [20 / the source drain field of N type, and 21 / the

aluminum electrode of the 1st layer and 25] the aluminum electrodes of a two-layer eye. An interlayer insulation film 23 possesses the three-tiered structure of TEOS film 23 a/SOG film 23 b/TEOS film 23c. [0008] The gate electrode 16, the control gate 19, and the lower electrode 21 consist of the tungsten silicide film (WSi) 31 of about 1500Å of thickness formed on the polish recon layer 30 of about 1500Å of thickness, and the polish recon layer 30 for reducing gate resistance. In order to prevent oxidation of the silicide film 31, the TEOS oxide film 32 (the 1st insulator layer) of about 100Å of thickness covers the silicide film 31 top, and the silicon nitride 33 of about 300Å of thickness covers it on the TEOS oxide film 32 further. The insulator layers 34 (the 2nd insulator layer), such as a BPSG film, cover the upper part of the silicon nitride 33 further.

[0009] The TEOS oxide film 32 and the silicon nitride 33 have covered the **** surface of a substrate except for the contact hole of an electrode 24, and also cover the upper part of the lower electrode 21 with the same laminated structure to coincidence. And the capacitive element 11 is formed because the up electrode 22 and the lower electrode 21 sandwich the TEOS oxide film 32 and the silicon nitride 33 by opening formed in the insulator layer 34.

[0010] This configuration can be obtained by the manufacture method like a less or equal. First, with reference to drawing 2 (A), the oxide film 38 of 100Å of thickness numbers is formed in the P-type semiconductor layer 11 surface, a silicon nitride is deposited with a CVD method on it, patterning of this is carried out, and the anti-oxidation film 40 is formed. After performing formation of a channel stop field etc., the LOCOS oxide film 15 for isolation is formed by oxidizing the whole substrate thermally for several hours.

[0011] With reference to drawing 2 (B), the anti-oxidation film 40 is removed, the oxide film 38 of the element field surface surrounded with the LOCOS oxide film 15 is removed, the surface is oxidized again, and gate oxide 39 of about 150Å of pure thickness is formed. A polish recon layer is deposited with a CVD method on it, and after carrying out a phosphorus dope, anti-oxidation films, such as a silicon nitride, are formed on a polish recon layer. This anti-oxidation film is etched, opening is formed, selective oxidation of the polish recon layer surface equivalent to the floating-gate electrode 18 is carried out, and the comparatively thick oxide film 41 of 1000–2000Å of thickness is formed. And the floating-gate electrode 18 of a memory device 12 is formed by removing an anti-oxidation film and etching a lower polish recon layer by using said comparatively thick oxide film as a mask.

[0012] The 2nd gate oxide is formed in the element field surface surrounded with the LOCOS oxide film 15 with reference to drawing 3 (A), and the gate electrode 16 of MOS device 13, the control gate 19 of a memory device 12, and the lower electrode 21 of a capacitive element 11 are formed by deposition of deposition of the polish recon layer 30, a phosphorus dope, and the tungsten silicide film 31, and photoetching of the polish recon layer 30 and the silicide film 31. Subsequently, the source drain fields 17 and 20 of N type are formed by performing the ion implantation of Lynn by using a gate electrode as a mask. And a NSG film is deposited on the whole surface with a CVD method so that gate electrode 16 grade may be covered, and a spacer 42 is formed in both the sides of the gate electrode 16 by carrying out whole surface etchback of this by the anisotropy. A spacer 42 is formed also like both the sides of the lower electrode 21 of a capacitive element.

[0013] In order to protect the surface silicide film 31 from oxidation with reference to drawing 3 (B), the TEOS oxide film 32 of about 100Å of thickness is formed in the whole surface with a reduced pressure CVD method, the ion implantation of the arsenic is further carried out to the source drain fields 17 and 20 in piles from the surface, and hundreds of degrees C heat treatment for activating an impurity is performed for about 1 hour. And the silicon nitride 33 of about 300Å of thickness is formed in the whole surface with a reduced pressure CVD method.

[0014] After forming the opening which exposes the silicon nitride 33 of the capacitive element 11 section first by photoetching after depositing a BPSG film on the whole surface, considering as an insulator layer 34 with reference to drawing 4 and performing heat treatment for flattening and changing a resist mask, the contact hole on the contact hole which exposes the surface of a source drain field and the control gate 1, and a gate electrode (not shown) is formed shortly. This etching performs continuously the

BPSG film 34, the silicon nitride 33, and the TEOS film 32 by changing etching gas one by one. And an aluminum material is deposited by the sputter and the 1st layer electrode 24 and the up electrode 22 of a capacitive element 11 are formed by carrying out patterning of this.

[0015] With reference to drawing 5, TEOS oxide-film 23a of about 7000Å of thickness is formed by the plasma-CVD method on the 1st layer electrode 24, subsequently SOG film 23b is formed with a spin-on coat, and TEOS oxide-film 23c is again formed by the plasma-CVD method, it considers as an interlayer insulation film 23, and after forming a through hole in an interlayer insulation film 23 if needed, the two-layer electrode 25 is formed.

[0016] According to this invention explained above, since the lower electrode 21 of a capacitive element is formed in formation and coincidence of the gate electrode 16 and the up electrode 22 is formed in formation and coincidence of the 1st layer aluminum electrode 24, a production process can be simplified. With the flash memory element of the split mold shown especially in drawing 1, although it becomes a two-layer polish recon process, since it is difficult to use as a capacitive element 21 since it has the thick oxide film 41 between the floating-gate electrode 18 and the control gate, the technique of this application becomes effective.

[0017] Moreover, since an aluminum wiring material can be used for the silicide film 31 which is a refractory metal as a lower electrode 21 as an up electrode 22, it is possible to make series resistance of a capacitive element 11 very small. Furthermore, since the surface of the silicide film 31 is covered with the TEOS film 32 and the silicon nitride 33, the silicide film 31 can be certainly protected from the ambient atmosphere of an oxidizing quality, and the exfoliation from the polish recon layer by the grain of the silicide film 31 growing can be prevented. To needing about 500Å thickness for acquiring the same effect with TEOS film 32 simple substance, since the upper part is covered with the silicon nitride 33 which is an anti-oxidation film, thickness can be made very thin with 100Å. Although the cascade screen of the TEOS film 32 and the silicon nitride 33 turns into a dielectric thin film in a capacitive element 11, the dielectric constant of the TEOS film 32 has only the abbreviation one half of the silicon nitride 33. Therefore, if the TEOS film 32 is made thin, capacity value per unit area of a capacitive element 11 can be enlarged.

[0018] And further, the passivation effect can be given to the moisture which invades from SOG film 23b of an interlayer insulation film 23 because the silicon nitride 33 covers all elements, and the life of a hot carrier can be especially increased by N channel mold MOS device 13. Drawing 6 is the cross section showing the 2nd example of this invention. The same sign is laid down on the same part as drawing 1, and explanation is omitted. Carrying out the opening of the insulator layer 34 of the memory device 12 upper part using the selectivity of a BPSG film and a silicon nitride, and installing the electric-field electrode 43 on the silicon nitride 33 differ. Negative electric field are impressed to the electric-field electrode 43. Moreover, after the production process of drawing 4, the opening on the control gate 19 is formed at the same time it forms a through hole in an interlayer insulation film 23, and the electric-field electrode 43 is installed in formation and coincidence of the two-layer electrode 25.

[0019] The charge which memorizes information and **** accumulated emits and disappears by a certain fixed probability with time amount by accumulating the charge which the memory device 12 of a flash plate mold poured the charge (electron) into the floating-gate electrode 18, and was poured in with the energy barrier of the floating-gate electrode 18 and the insulator layer of the perimeter. In this example, since negative charge and the charge of stored charge (electron) oppose by impressing electric field negative with the electric-field electrode 43, a charge can be confined in the floating-gate electrode 18 interior. Therefore, it is possible to lengthen sharply the holding time of the storage information on a memory device 12.

[0020]

[Effect of the Invention] Since the lower electrode 21 and an aluminum electrode are constituted for the gate electrode 16 of silicide structure as an up electrode 22 according to this invention as explained above, it has the advantage which can simplify a manufacturing process. Moreover, since specific resistance can use a small electrode layer by silicide, it has the advantage which can reduce the series resistance of a capacitive element sharply.

[0021] Moreover, although the TEOS film 32 is used for some dielectric films, since the thickness can be made very thin by covering a it top with the silicon nitride 33, it has an advantage with the capacity value able to incorporate a big element per unit area. And since the whole element is covered with the silicon nitride 33, the passivation effect over moisture can be acquired and it also has the advantage which can increase the reliability of an integrated circuit.

[Translation done.]

* NOTICES *

Japan Patent Office is not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1.This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.*** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

DESCRIPTION OF DRAWINGS

[Brief Description of the Drawings]

[Drawing 1] It is a cross section for explaining this invention.

[Drawing 2] It is a cross section for explaining this invention.

[Drawing 3] It is a cross section for explaining this invention.

[Drawing 4] It is a cross section for explaining this invention.

[Drawing 5] It is a cross section for explaining this invention.

[Drawing 6] It is a cross section for explaining this invention.

[Drawing 7] It is a cross section for explaining the conventional example.

[Translation done.]

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平10-154792

(43) 公開日 平成10年(1998) 6月9日

(51) Int.Cl.⁶

識別記号

F I

H 0 1 L 27/04
21/822
27/115
21/8247
29/788

H 0 1 L 27/04
27/10
29/78

C

4 3 4
3 7 1

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 6 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願平8-310935

(22) 出願日 平成8年(1996)11月21日

(71) 出願人 000001889

三洋電機株式会社

大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号

(72) 発明者 青山 将茂

大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三
洋電機株式会社内

(72) 発明者 森川 成洋

大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三
洋電機株式会社内

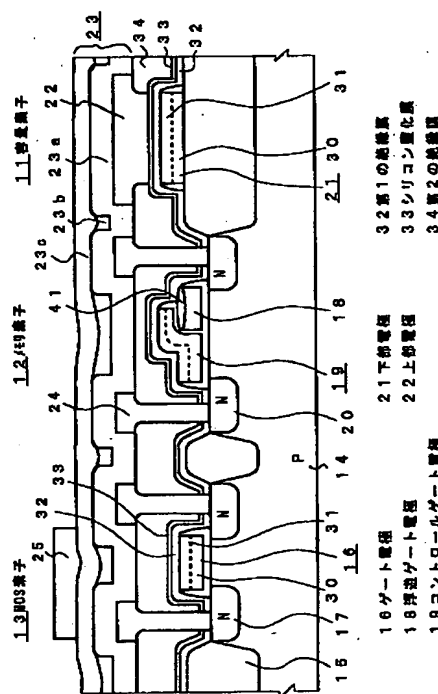
(74) 代理人 弁理士 安富 耕二 (外1名)

(54) 【発明の名称】 半導体集積回路とその製造方法

(57) 【要約】

【課題】 比抵抗の小さいゲート電極とアルミ電極とで容量素子を形成することにより高特性の容量素子を簡単な工程で組み込むこと。

【解決手段】 ポリシリコン層／シリサイド膜からなるゲート電極16を形成し、同時に容量素子1の下部電極21を形成する。シリサイド膜の上をTEOS膜32、シリコン窒化膜33で被覆し、TEOS膜32とシリコン窒化膜33を誘電体とする。絶縁膜を開口し、アルミ電極材料により容量素子11の上部電極22を形成する。



(2)

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 LOCOS酸化膜で囲まれた素子領域の表面に形成した浮遊ゲート電極と、

前記浮遊ゲート電極の上に形成した比較的厚い絶縁膜と、

前記素子領域の表面と前記比較的厚い絶縁膜の上に跨るように形成したコントロールゲート電極と、

前記コントロールゲート電極と同時的に前記LOCOS酸化膜上に形成した、容量素子の下部電極と、

前記コントロールゲート電極と前記下部電極の上を被覆する第1の絶縁膜及び第1の絶縁膜の上を被覆する誘電体薄膜と、

前記誘電体薄膜の上を被覆する第2の絶縁膜と、

前記下部電極の上部で前記誘電体薄膜の表面を露出する、

前記第2の絶縁膜の開口部と、

前記開口部で前記下部電極と対向する上部電極と、を具備することを特徴とする半導体集積回路。

【請求項2】一導電型の半導体層の表面を選択酸化してLOCOS絶縁膜を形成する工程と、

前記LOCOS酸化膜で囲まれた前記一導電型の半導体層の表面に浮遊ゲート電極を形成する工程と、

前記半導体層の上と前記浮遊ゲート電極の上を跨るようにコントロールゲート電極を形成し、前記LOCOS酸化膜の上には容量素子の下部電極を形成する工程と、

前記コントロールゲート電極と前記下部電極との上を第1の絶縁膜で被覆し、更に前記第1の絶縁膜の上に誘電体薄膜を形成する工程と、

前記誘電体薄膜の上に第2の絶縁膜を形成する工程と、

前記第2の絶縁膜の前記下部電極に対応する部分に開口部を形成する工程と、

前記開口部を覆うように前記下部電極と対向する容量素子の上部電極を形成する工程と、を具備することを特徴とする半導体集積回路の製造方法。

【請求項3】 前記コントロールゲート電極が、多結晶シリコンとシリサイド膜との積層構造を具備し、且つ前記第1の絶縁膜と前記誘電体薄膜との積層構造を誘電体とすることを特徴とする請求項1記載の半導体集積回路。

【請求項4】 前記コントロール電極の上方に、前記コントロールゲート電極とは絶縁され前記浮遊ゲート電極に電界を印加する電極を配置したことを特徴とする請求項1記載の半導体集積回路。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、MOS型集積回路に比較的大容量の容量素子を簡素な工程で組み込むことができる半導体集積回路の製造方法に関する。

【0002】

【従来の技術】集積回路に組み込む容量素子として最も簡便な構造はPN接合を用いる構造であるが、得られる

2

容量値が小さいため、例えば特開平03-69152号に記載されているように、酸化膜を誘電体として用いるMOS型、シリコン窒化膜を誘電体として用いるMIS型、対向電極として両方とも電極配線材料を用いるMIM型の構成が考えられている。

【0003】MIS型の構成は、図7(A)に示すように、N+拡散層1を下部電極としてその上にシリコン窒化膜2を形成し、その上に上部電極3を形成した構成である。MIM型の構成は、図7(B)に示すように、電極配線層の一部を下部電極4としその上にシリコン窒化膜5を形成し、更にその上に電極配線層にて上部電極6を形成したものである。

【0004】これらの容量素子は、たとえばスイッチトキャパシタフィルタ回路用として、マイコン、ロジック等のデジタルLSIにも組み込みたい要求が強い。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、ますます複雑化・高集積化するLSIプロセスの中でこのような容量素子を組み込むことは、プロセスを更に複雑化するという欠点がある。

【0006】

【課題を解決するための手段】本発明は、上述した従来の課題に鑑み成されたもので、ゲート電極と容量素子の下部電極とを同時に形成し、ゲート電極を被覆する第1の絶縁膜と誘電体薄膜を全体に堆積し、そして第1の絶縁膜と誘電体薄膜とを容量素子の誘電体とするように上部電極を設けることにより、工程を簡略化しつつ容量素子以外の素子をも誘電体薄膜で被覆して素子の信頼性を向上できる集積回路を提供するものである。

【0007】

【発明の実施の形態】以下に本発明の一実施の形態を図面を参照しながら詳細に説明する。図1は本発明の集積回路の一例を示す断面図であり、容量素子11、フラッシュ型のメモリ素子12、およびNチャンネルMOS素子13を集積化した例である。同図において、14はP型の半導体層を示し、15は半導体層14の表面を選択酸化することにより形成した素子分離用のLOCOS酸化膜、16はMOS素子13のゲート電極、17はMOS素子13のN型ソース・ドレイン領域、18はフラッシュ型メモリ素子12の浮遊ゲート電極、19は浮遊ゲート電極18上に位置するコントロールゲート、20はN型のソース・ドレイン領域、21は容量素子11の下部電極、22は容量素子12の上部電極、23は層間絶縁膜、24は1層目のアルミ電極、25は2層目のアルミ電極である。層間絶縁膜23は、TEOS膜23a/SOG膜23b/TEOS膜23cの3層構造を具備する。

【0008】ゲート電極16、コントロールゲート19、及び下部電極21は、膜厚1500Å程度のポリシリコン層30と、ゲート抵抗を低減する為の、ポリシリ

(3)

3

コン層30の上に形成した膜厚1500Å程度のタングステンシリサイド膜(WSi)31とから成る。シリサイド膜31の上はシリサイド膜31の酸化を防止するために膜厚100Å程度のTEOS酸化膜32(第1の絶縁膜)が被覆し、さらにTEOS酸化膜32の上に膜厚300Å程度のシリコン窒化膜33が被覆する。シリコン窒化膜33の上部は更にBP SG膜等の絶縁膜34(第2の絶縁膜)が被覆する。

【0009】TEOS酸化膜32とシリコン窒化膜33とは電極24のコンタクトホールを除いて基板の略全表面を被覆しており、同時に下部電極21の上部も同様の積層構造で被覆する。そして、絶縁膜34に形成した開口部で上部電極22と下部電極21がTEOS酸化膜32とシリコン窒化膜33を挟むことで容量素子11を形成している。

【0010】斯かる構成は、以下の如き製造方法によって得ることができる。先ず図2(A)を参照して、P型半導体層11表面に膜厚数百Åの酸化膜38を形成し、その上にCVD法によりシリコン窒化膜を堆積し、これをパターニングして耐酸化膜40を形成する。チャンネルストップ領域の形成などを行った後、基板全体を数時間熱酸化することにより素子分離用のLOCOS酸化膜15を形成する。

【0011】図2(B)を参照して、耐酸化膜40を除去し、LOCOS酸化膜15で囲まれた素子領域表面の酸化膜38を除去し、その表面を再度酸化して清浄な膜厚150Å程度のゲート酸化膜39を形成する。その上にCVD法によりポリシリコン層を堆積し、リンドープした後ポリシリコン層の上にシリコン窒化膜等の耐酸化膜を形成する。該耐酸化膜をエッチングして開口部を形成し、浮遊ゲート電極18に相当するポリシリコン層表面を選択酸化して膜厚1000~2000Åの比較的厚い酸化膜41を形成する。そして耐酸化膜を除去し、前記比較的厚い酸化膜をマスクとして下のポリシリコン層をエッチングすることでメモリ素子12の浮遊ゲート電極18を形成する。

【0012】図3(A)を参照して、LOCOS酸化膜15で囲まれた素子領域表面に2回目のゲート酸化膜を形成し、ポリシリコン層30の堆積、リンドープ、タングステンシリサイド膜31の堆積、ポリシリコン層30とシリサイド膜31とのホットエッチングにより、MOS素子13のゲート電極16、メモリ素子12のコントロールゲート19、及び容量素子11の下部電極21を形成する。次いで、ゲート電極をマスクとしてリンのイオン注入を行う事によりN型のソース・ドレイン領域17、20を形成する。そして、ゲート電極16等を被覆するように全面にCVD法によりNSG膜を堆積し、これを異方性で全面エッチバックすることによりゲート電極16の両脇にスペーサ42を形成する。容量素子の下部電極21の両脇にも同様にスペーサ42が形成され

4

る。

【0013】図3(B)を参照して、表面のシリサイド膜31を酸化から保護するために、全面に減圧CVD法により膜厚100Å程度のTEOS酸化膜32を形成し、更に表面からヒ素をソース・ドレイン領域17、20に重ねてイオン注入し、不純物を活性化するための数百℃の熱処理を1時間程度行う。そして全面に減圧CVD法により膜厚300Å程度のシリコン窒化膜33を形成する。

【0014】図4を参照して、全面にBP SG膜を堆積して絶縁膜34とし、平坦化の為の熱処理を行った後、ホットエッチングにより先ず容量素子11部のシリコン窒化膜33を露出する開口部を形成し、レジストマスクを変更した後、今度はソース・ドレイン領域の表面を露出するコンタクトホール、およびコントロールゲート1とゲート電極上のコンタクト孔(図示せず)を形成する。このエッチングは、BP SG膜34、シリコン窒化膜33、TEOS膜32を順次エッチングガスを切り替えることで連続的に行う。そしてスパッタ法によりアルミニウム材料を堆積し、これをパターニングすることにより1層目電極24と容量素子11の上部電極22を形成する。

【0015】図5を参照して、1層目電極24の上にプラズマCVD法により膜厚7000Å程度のTEOS酸化膜23aを形成し、次いでSOG膜23bをスピノコートにより形成し、再度プラズマCVD法によりTEOS酸化膜23cを形成して層間絶縁膜23とし、必要に応じて層間絶縁膜23にスルーホールを形成した後2層目電極25を形成する。

【0016】以上に説明した本発明によれば、ゲート電極16の形成と同時に容量素子の下部電極21を、1層目アルミ電極24の形成と同時に上部電極22を形成するので、工程を簡素化することができる。特に図1に示したスプリット型のフラッシュメモリ素子では、2層ポリシリコンプロセスとなるものの、浮遊ゲート電極18とコントロールゲートとの間に厚い酸化膜41を有するので容量素子21として利用するのが難しいので、本願の手法が有効となる。

【0017】また、下部電極21として高融点金属であるシリサイド膜31を、上部電極22としてアルミ配線材料を用いることができるので、容量素子11の直列抵抗を極めて小さくすることが可能である。さらに、シリサイド膜31の表面をTEOS膜32とシリコン窒化膜33で被覆するので、シリサイド膜31を酸化性の雰囲気から確実に保護することができ、シリサイド膜31のグレインが成長することによるポリシリコン層からの剥離を防止できる。同じ効果を得るのにTEOS膜32単体では500Å程度の膜厚を必要とするのに対し、上部を耐酸化膜であるシリコン窒化膜33で被覆するので膜厚を100Åと極めて薄くすることができる。容量素子

(4)

5

11においてはTEOS膜32とシリコン窒化膜33との積層膜が誘電体薄膜となるが、TEOS膜32の誘電率はシリコン窒化膜33の約半分しかない。従ってTEOS膜32を薄くすれば、容量素子11の単位面積当たりの容量値を大きくすることができる。

【0018】そして更に、シリコン窒化膜33が全素子を被覆することで、例えば層間絶縁膜23のSOG膜23bから侵入する水分に対してパッシベーション効果を持たせることができ、特にNチャンネル型MOS素子13でホットキャリアの寿命を増大できるものである。図6は本発明の第2の実施例を示す断面図である。図1と同じ箇所には同じ符号を伏して説明を省略する。異なるのは、BPSG膜とシリコン窒化膜との選択性を利用してメモリ素子12上部の絶縁膜34を開口し、シリコン窒化膜33上に電界電極43を設置することである。電界電極43には負の電界を印加してある。また、図4の工程の後、層間絶縁膜23にスルーホールを形成すると同時にコントロールゲート19上の開口を形成し、2層目電極25の形成と同時に電界電極43を設置している。

【0019】フラッシュ型のメモリ素子12は浮遊ゲート電極18に電荷（電子）を注入し、浮遊ゲート電極18とその周囲の絶縁膜とのエネルギー障壁により注入した電荷を蓄積することにより情報を記憶するものであり、蓄積した電荷は時間と共にある一定の確率で放出・消滅する。この実施例では、電界電極43で負の電界を印加することにより、負の電荷と蓄積電荷（電子）の電荷とが反発することから、電荷を浮遊ゲート電極18内

6

部に閉じこめることができる。したがってメモリ素子12の記憶情報の保持時間を大幅にのばすことが可能である。

【0020】

【発明の効果】以上に説明した通り、本発明によれば、シリサイド構造のゲート電極16を下部電極21、アルミ電極を上部電極22として構成するので、製造工程を簡素化できる利点を有する。また、シリサイドにより比抵抗が小さい電極層を用いることができるので、容量素子の直列抵抗を大幅に減じることができる利点を有する。

【0021】また、誘電体膜の一部にTEOS膜32を用いるものの、その上をシリコン窒化膜33で被覆することによりその膜厚を極めて薄くできるので、単位面積当たりの容量値が大きな素子を組み込むことが可能である利点を有する。そして、素子全体をシリコン窒化膜33で被覆するので、水分に対するパッシベーション効果を得ることができ、集積回路の信頼性を増大できる利点をも有する。

20 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明を説明するための断面図である。

【図2】本発明を説明するための断面図である。

【図3】本発明を説明するための断面図である。

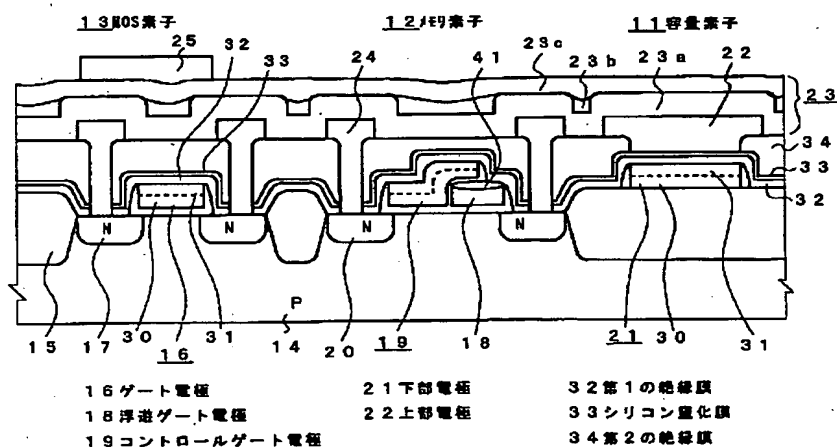
【図4】本発明を説明するための断面図である。

【図5】本発明を説明するための断面図である。

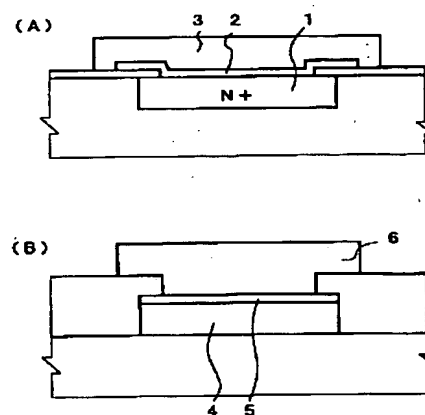
【図6】本発明を説明するための断面図である。

【図7】従来例を説明するための断面図である。

【図1】

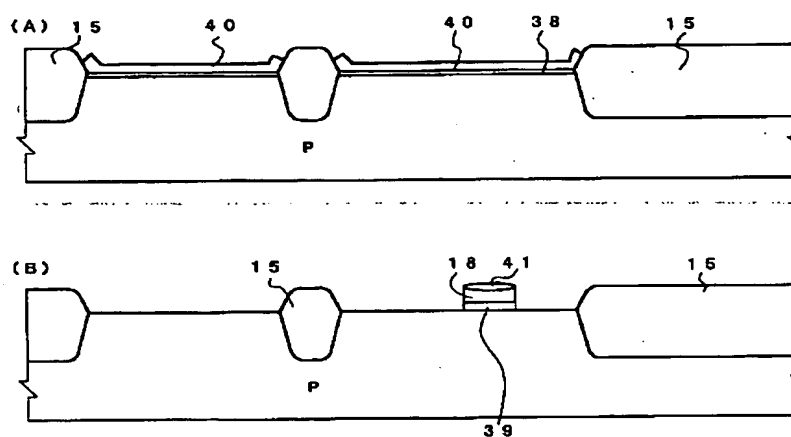


【図7】

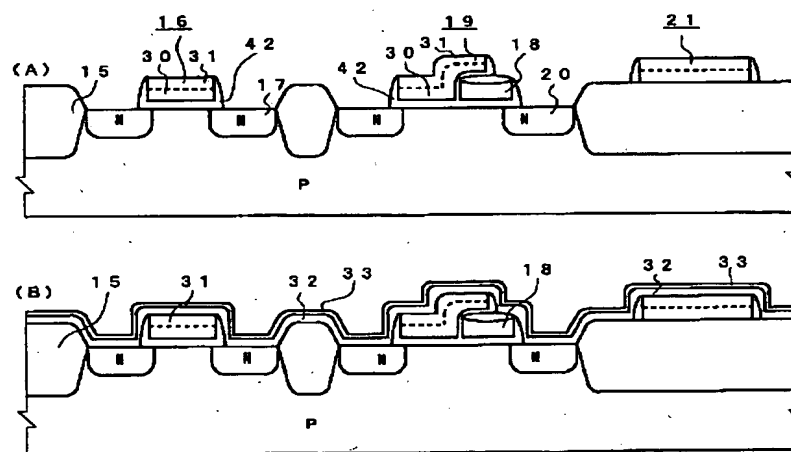


(5)

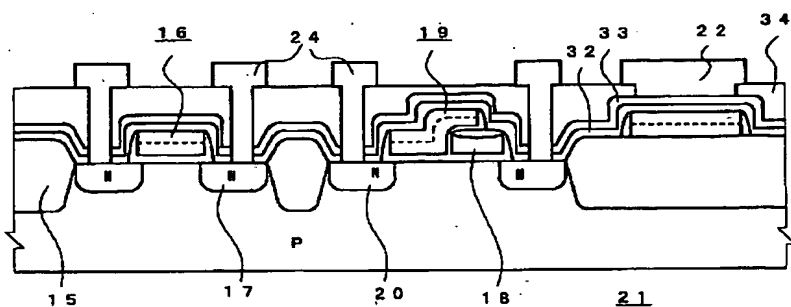
【図2】



【図3】

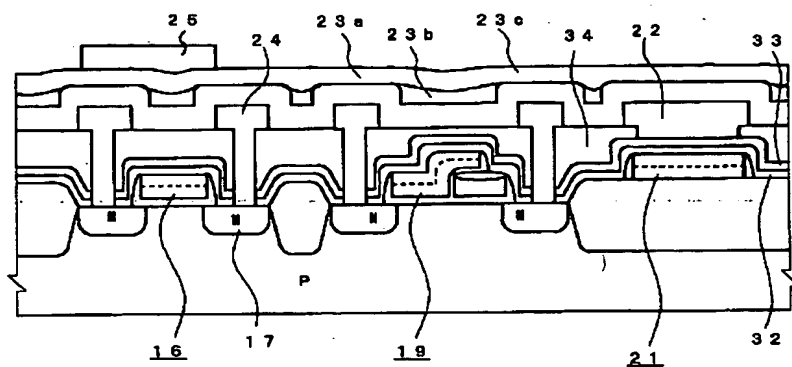


【図4】

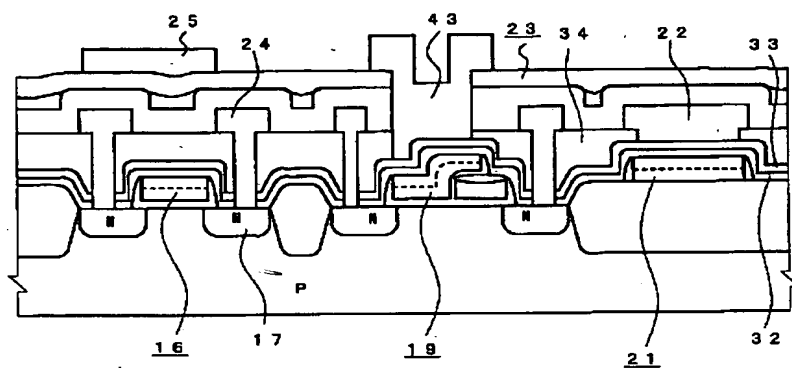


(6)

【図5】



【図6】



フロントページの続き

(51) Int. Cl. 6
H01L 29/792

識別記号

F I